

技术规格书

High Power Diode Laser Bars, 865nm, 50W

865nm 50W 高功率巴条激光芯片

产品型号 DG-UMB-30-19-865-TE-50-1.0

性能参数 Performance Parameters	符号 Symbol	最小值 Minimum	典型值 Typical	最大值 Maximum	单位 Unit
光学性能 Optical					
输出功率 Optical output power	P _o		50		W
中心波长 Wavelength	λ _c	877	865	883	nm
冷波长 Wavelength	λ ₀	861	863	865	nm
工作模式 Operation mode			CW		
水平远场发散角(95% E) Horizontal F.F.divergence angle	θ _{//}		/		Deg
垂直远场发散角(95% E) Vertical F.F. divergence angle	θ _⊥		/		Deg
光谱宽度 Spectral width (FWHM)	Δλ		2	4	nm
波长温度系数 Wavelength temperature coefficient	Δλ/ΔT		0.3		nm/°C
电学性能 Electrical					
电光转换效率 E-O conversion efficiency	η _c	65	68		%
斜率效率 Slope efficiency	SE	1.25	1.34		W/A
阈值电流 Threshold current	I _{th}		8.5	9.5	A
工作电流 Operating current	I _{op}		46	50	A
工作电压 Operating voltage	V _{op}		1.60	1.70	V
几何尺寸 Geometrical					
发光点数量 Number of emitters			19		
发光区宽度 Emitter width	E.W.	151	156	161	μm
发光区间距 Emitter pitch	P		500		μm
巴条填充因子 Fill factor	F		30		%
腔长 Cavity length	L	980	1000	1020	μm
巴条宽度 Bar width	W	9800	10000	10200	μm
巴条厚度 Bar thickness	D	105	115	125	μm

备注：本参数为产品进行 MCC 封装，CW 电流模式，导热板 25℃ 条件下的测试参数。

Note: These parameters were obtained by testing MCC packaged products in the CW mode at 25°C.



本文件及其披露的任何数据的所有权均属于度亘核芯光电技术（苏州）有限公司，构成并包含专有信息。除非度亘核芯光电技术（苏州）有限公司明确书面授权，否则不具有任何接收或拥有本文件授予或转让复制、使用或披露本文件所含任何信息的权利。

DG-SPEC-058 865nm 50W 30-19-1.0 高功率巴条激光芯片

REV: A0

商业秘密

变更记录

版本	日期	变更记录	制 修订人	批准人
A0	2024.11.15	新制定	王滔	彭青